

2024年11月18日（月）

A会場 （3F・アーバンテックホール）

シンポジウム 11月18日（月） 13:30～17:20

バルク成長分科会/ナノ構造・エピタキシャル成長分科会合同シンポジウム

「ワイドギャップ半導体 β -Ga₂O₃のバルク単結晶育成とエピタキシャル成長の進展」

（座長：大島孝仁/物材機構，太子敏則/信大）

13:30		はじめに	熊谷義直	農工大院工
13:35	18p-A06	融液成長法による β -Ga ₂ O ₃ 単結晶の作製	五十嵐拓也，上田悠貴，山口博隆，奥公祥，阪口良一，渡辺信也，山腰茂伸，倉又朗人	(株)ノバルクリスタルテクノロジー，産総研
14:05	18p-A07	垂直ブリッジマン（VB）法による β -Ga ₂ O ₃ 単結晶育成と評価	太子敏則，干川圭吾	信大工
14:35	18p-A08	貴金属ルツボを用いない β -Ga ₂ O ₃ バルク単結晶の融液成長	吉川彰，V. V. Kochurikhin，富田健稔，北原正典，鎌田 圭，庄子育宏，柿本浩一	東北大，(株)FOX，(株)C&A，九大
15:05-15:15		【休憩】		
15:15	18p-A09	ミストCVD法による β -Ga ₂ O ₃ のホモエピタキシャル成長	藤田静雄，田中勝久	京大
15:45	18p-A10	MOVPE法によるパワーデバイス向け β -Ga ₂ O ₃ ホモエピウエハの開発	吉永純也，奥山貴仁，窪田翔海，寺内悠真，佐々木捷悟，池永和正，椎名一成，小関修一，伴雄三郎，熊谷義直	農工大院工，大陽日酸(株)，奈良女大，大陽日酸ATI(株)
16:15	18p-A11	($\bar{1}02$) β -Ga ₂ O ₃ 基板上的ホモ・ヘテロエピタキシとプラズマフリー微細加工	大島孝仁，大島祐一，中込真二	物材機構，石巻専修大
16:45	18p-A12	MBE法による β -(Al _x Ga _{1-x}) ₂ O ₃ 薄膜の成長と高周波Ga ₂ O ₃ トランジスタへの応用	大槻匠，上村崇史，東脇正高	情通機構，阪公大
17:15		おわりに	太子敏則	信大工